

### Lagenaufbau

| Ebene |                                                                                   | Komponente           | Dicke (mm) | Cu (my) | Typ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|-----|
| 1     |  | Cu+galv.Cu           | 1.964      | 18+25   |     |
| 2     |                                                                                   | Tr-Lam<br>Cu+galv.Cu |            | 18+25   |     |

|                                              |      |          |
|----------------------------------------------|------|----------|
| Basismaterialdicke:                          | 2,00 | +/- 10 % |
| Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske: | 2,11 | +/- 10 % |

### Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe
- abhängig von gewählter Kupferdicke abweichende Isolationsdicke

### Designrules zum Lagenaufbau

|                                |                                     |          |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Durchgangslöcher [A]<br>(Vias) | End-Ø                               | ≥ 250 µm |
|                                | Viapad-Ø                            | ≥ 550 µm |
| Leiterbild Außenlagen          |                                     |          |
| Standard                       | Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer  | ≥ 100 µm |
|                                | Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer | ≥ 120 µm |
|                                | Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer  | ≥ 130 µm |
|                                | Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer | ≥ 175 µm |
|                                | Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer  | ≥ 190 µm |
|                                | Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer | ≥ 240 µm |

Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer  
Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer

≥ 250 µm  
≥ 320 µm